

CLEAR CARBON エピタキシャル成長用SiCサセプター

CLEAR CARBON SiC Susceptor for Epitaxial Growth

コバレントマテリアル独自の、黒鉛基材への耐食性に優れたSiCコーティング製品

CLEAR CARBON is a graphite material coated with a unique and superior corrosion-resistant silicon carbide film.

エピタキシャル成長用としてシェアNo.1

CLEAR CARBON is No.1 in market share and is the top brand of susceptors for epitaxial growth.

エピタキシャル装置への純正サプライヤーとして数多くの実績

As the official susceptor supplier to wide range of Epi reactors, CLEAR CARBON has been globally used.

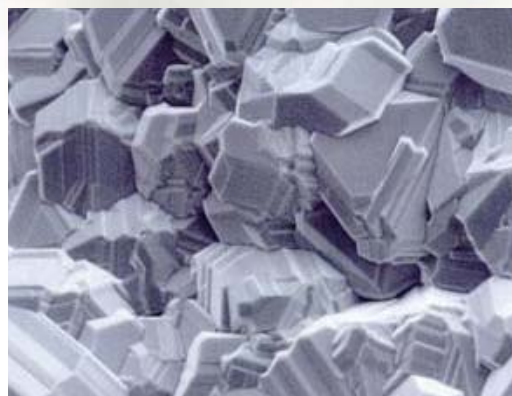
歪シリコン形成、化合物半導体用MO-CVD にも貢献

CLEAR CARBON also contributes to strained-silicon and MO-CVD for compound semiconductor.

※MO-CVDとはMetal Organic Chemical Vapor Depositionのことです。 MO-CVD stands for Metal Organic Chemical Vapor Deposition

CLEAR CARBONの特長 Unique features of CLEAR CARBON

- 高温耐久性に優れる
Superior durability at high temperatures
- 強固な黒鉛基材とSiCコート膜との密着構造
Superior bonding between graphite substrate and SiC coat.
- 複雑形状へのコーティングが可能
SiC coating is available for complex shapes
- 広範囲にわたる表面仕上げの要望に適応可能
Capability to meet wide range of surface finish requirement



Well grown SiC crystal of CLEAR CARBON

CLEAR CARBONの耐熱試験 CLEAR CARBON heat resistance tests

	Gas	Temperature (°C)					
		1300	1350	1400	1450	1500	1550
CLEAR CARBON	H ₂	◎	◎	◎	◎	◎	○
	H ₂ +HCl	◎	◎	◎	◎	◎	△
General SiC-CVD film	H ₂	◎	◎	◎	○	○	△
	H ₂ +HCl	◎	◎	◎	×	×	×

[判定内容]
Details of
determination

◎: 問題なし
No problem
△: やや昇華
Some sublimation

○: 表面やや欠損
Some surface defects
×: 昇華大
Excessive sublimation

[処理条件]
Treatment
conditions

H₂:H₂=20SLM, 100Torr, 60min
H₂+HCl:H₂=20SLM, HCl=0.5SLM,
100Torr, 60min

COVALENT

コバレントマテリアル株式会社

セラミックス事業本部

東京都品川区大崎1-6-3 日精ビルディング 〒141-0032

Tel:03-5437-8408 Fax:03-5437-7395

www.covalent.co.jp